

КТ8170
высоковольтный биполярный
эпитаксиально-планарный
п-р-п транзистор

Назначение

Транзистор п-р-п кремниевый эпитаксиально-планарный. Предназначен для использования в импульсных источниках питания, пускорегулирующих устройствах и другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства

Зарубежные прототипы

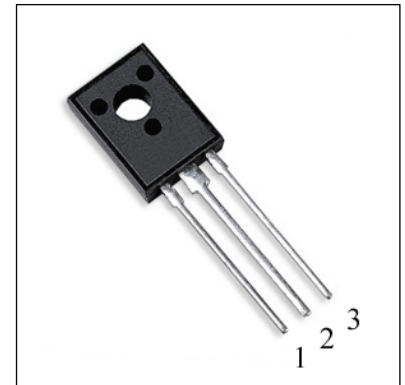
- прототипы - MJE13003, MJE13002

Номер технических условий

- АДБК. 432140. 603 ТУ

Особенности

- диапазон рабочих температур от - 60 до + 100 °С



Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-27 (ТО-126)

Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	База
№2	Коллектор
№3	Эмиттер

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ8170 при $T_{\text{окр. среды}} = +25^\circ\text{C}$

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Гран. напряжение коллектор-эмиттер КТ8170А1 КТ8170Б1	* $U_{кэ\text{о гр.}}$	В	$I_k=10\text{mA}, I_b=0$	400 300	
Обратный ток коллектор-эмиттер КТ8170А1 КТ8170Б1	* $I_{кэк}$	мА	$U_{кэ} = 700\text{В}, U_{эб} = 0$ $U_{кэ} = 600\text{В}, U_{эб} = 0$		1,0 1,0
Обратный ток коллектор-эмиттер КТ8170А1	* $I_{кэо}$	мкА	$U_{кэ} = 400\text{В}, R_{эб} = \infty$ $U_{кэ} = 300\text{В}, R_{эб} = \infty$		3,0 3,0
Обратный ток эмиттера	$I_{эбо}$	мА	$U_{эб} = 9\text{В}, I_k = 0$		1,0
Статический коэффициент передачи тока	* h_{21E}		$U_{кэ} = 2\text{В}, I_k = 0,5\text{А}$ $U_{кэ} = 2\text{В}, I_k = 1,0\text{А}$	8 5	40 25
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	* $U_{кэнас}$	В	$I_k = 0,5\text{А}, I_b = 0,1\text{А}$ $I_k = 1,0\text{А}, I_b = 0,25\text{А}$ $I_k = 1,5\text{А}, I_b = 0,5\text{А}$		0,5 1,0 3,0
Напряжение насыщения база-эмиттер	* $U_{бэнас}$	В	$I_k = 0,5\text{А}, I_b = 0,1\text{А}$ $I_k = 1,0\text{А}, I_b = 0,25\text{А}$		1,0 1,2
Граничная частота коэф. передачи тока	$f_{гр.}$	МГц	$U_{кэ} = 5\text{В}, I_k = 0,1\text{А}$	4,0	
Емкость коллекторного перехода	C_k	пФ	$U_{кб} = 10\text{В}, I_{э} = 0, f = 1\text{МГц}$		35
Время включения	* $t_{вкл.}$	мкс	$U_{кэ} = 125\text{В}, I_k = 1\text{А},$ $I_{Б1} = I_{Б2} = 0,2\text{А}$		1,1
Время спада	* $t_{сп.}$				0,7
Время рассасывания	* $t_{рас.}$				4,0

* - $t_i \leq 300\text{мкс}, Q > 50$

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ8170

Параметры	Обозначение	Ед измер.	Значение
Напряжение коллектор-база КТ8170А1 КТ8170Б1	$U_{кб\text{ max}}$	В	700 600
Напряжение коллектор-эмиттер КТ8170А1 КТ8170Б1	$U_{кэ\text{ max}}$	В	400 300
Напряжение эмиттер-база	$U_{эб\text{ max}}$	В	9
Постоянный ток коллектора	$I_k\text{ max}$	А	1,5
Импульсный ток коллектора ($t_u \leq 5\text{ мс}, Q \geq 10$)	$I_{ки\text{ max}}$	А	3,0
Постоянный ток эмиттера	$I_{э\text{ max}}$	А	2,25
Постоянный ток базы	$I_b\text{ max}$	А	0,75
Рассеиваемая мощность коллектора: при $T_{\text{корп}} = \text{от } -60 \text{ до } +25^\circ\text{C}$ при $T_{\text{среды}} = \text{от } -60 \text{ до } +25^\circ\text{C}$	$P_k\text{ max}$	Вт	40,0 1,0



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>